## Translation of Citation 4

Japanese Patent Public Disclosure No. 24826/93 Japanese Patent Application No. 181157/91 Filed: July 22, 1991

Applicant: Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.

Title of Invention:

Method of Producing Semiconductor Super-fine Particles and Composition

## Claims

- 1. A method of producing semiconductor super-fine particles, characterized in that a raw material of the semiconductor super-fine particles of chalcogenide and a stabilizer for the particles to be produced are coexisted in a nonaqueous solvent and the temperature of reaction is controlled, thereby arbitrarily controlling the diameter distribution of the resultant semiconductor super-fine particles of chalcogenide.
- 2. The method according to claim 1, characterized in that a polymer containing a pyrrolidone radical is used as the stabilizer.
- 3. A polymeric composition containing dispersed semiconductor super-fine particles having a controlled diameter distribution, characterized in that the polymeric composition is produced by coexisting in a nonaqueous solvent a raw material of the semiconductor super-fine particles of chalcogenide and a stabilizer for the particles to be produced and controlling the temperature of reaction to remove the solvent from the disperse solution.
- 4. The polymeric composition according to claim 3, characterized in that a polymer containing a pyrrolidone radical is used as the stabilizer.

# Detailed Descriptions [0001]

The present invention relates to a method of producing super-fine particles of chalcogenide used in catalytic reactions, optical materials, etc. and a polymeric composition with the super-fine particles being dispersed therein.

[0012]

The super-fine particles of the present invention have an average diameter of 10-1000 Å, preferably 10-200 Å. The diameter may be either that of primary particles or that of secondary particles formed by aggregating the primary particles. In either case, in order to exhibit transparency to visible light, particles having a diameter of 1000 Å or more are not preferred in view of the scattering of light.

#### [0013]

The production of the super-fine particles of chalcogenide of the present invention is conducted by the reaction of a metal compound with a chalcogenization agent.

## [0014]

More specifically, a solution containing the metal compound is kept at a temperature arbitrarily adjusted between the coagulation point and the boiling point of the solvent under the presence of a stabilizer, while agitating the solution according to demand. Then, the chalcogenization agent is added to the solution, whereby super-fine particles of metal chalcogenide having a controlled diameter distribution are formed in the solution.

Citation 4

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出限公開番号

## 特開平5-24826

(43)公開日 平成5年(1998)2月2日

F I 技術表示傾息
審査請求 米請求 諸求項の数4(全 6 頁)
(71) 出职人 000003128 三井東圧化学株式会社
東京都千代田区蔵が関三丁目 2番 5号
(72) 帝明者 高原 茂
神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井
東圧化学株式会社内
(72)発明者 成類 功
神奈川県横浜市栄区笠岡町1190番地 三井
東圧化学株式会社内
(72)発明者林 土土治
神奈川県朝浜市栄区笠南町1190番地 三手 東圧化学株式会社内

(64) 【発明の名称】 半導体超微粒子の製造方法および組成物

## (57)【栗約】

【構成】 カルコゲン化物半導体超微粒子を非水溶媒中で、その安定剤化存在下において、反応湿度を制御して製造する方法。ならびにそれによって製造されるカルコゲン化物半導体超級粒子分散溶液より、溶媒を除去することにより得られる超微粒子/ポリマー組成物。

【効果】 カルコゲン化物図数粒子の粒径分布が反応温度によって、任意に制御された半導体超微粒子およびその頑張粒子/ポリマー組成物が得られる。

特期平5-24826

(2)

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 非水溶媒中に、カルコゲン化物半導体組 **敬粒子原料と製造されるカルコゲン化物半等体超像粒子** の安定化剤を共存させ、反応温度を制御するととによっ て、製造されるカルコゲン化物半導体超級粒子の粒径の 粒径分布を任業に制御する半導体超粒子の製造方法。

【師求項2】 半導体超敏粒子の安定化剤として、ピロ リドン基を有するポリマーを用いる繭水項 1 記憶の半導 体超微粒子の製造方法。

【請求項3】 非水溶媒中に、カルコゲン化物半導体的 10 微粒子原料と製造されるカルコゲン化物半導体超微粒子 の安定化剤を共存させ、反応温度を制御するととによっ て製造されるカルコゲン化物半導体超微粒子の分散溶液 より、溶媒を除去することにより得られる粒径分布が削 御された超像粒子が分散された分散ポリマー組成物。

【鞠求項4】 半導体阻微粒子の安定化剤として、ピロ リドン基を有するボリマーを用いる請求項3記載の超激 粒子分散ポリマー組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、触媒反応や光学材料に 用いられるカルコゲン化物部像粒子の製造方法及びその 超像粒子が分散されたボリマー組成物に関する。さらに 詳しくは、光波長カットフィルター、発光材料、あるい は光通信などに用いられる光電子デバイスとして、位相 共復被発生や光双安定現象を利用する非線形光学材料な どに用いられるカルコゲン化物超微粒子の製造方法及び その超微粒子が分散されたポリマー組成物に関する。 [0002]

【従来の技術】従来、溶液中での半導体超微粒子の製造 30 方法としては、水溶液中での製造例が多く知られてい る。例えば、とれまで開示されているカルコゲン化物超 **敬粒子の合成例としては、製造される超微粒子の安定化** 剤としてヘキサメタ構酸ナトリウムを用い、過塩素酸カ ドミウムあるいは過塩素酸亜鉛水溶液に硫化水素を反応 させることにより硫化カトミウムあるいは硫化亜鉛配像 粒子を製造している例がある(ベリヒテ・ブンゼンゲゼ ルシャフト・フィジカリシェ・ヘミー(Ber.Bunsenges.P hys.Chem.)第88巻,969頁,(1984年) あるいは同誌 第88 卷,64領,(1984年))。

【0003】とのようにして製造される超微粒子及び製 造上の形態である超微粒子コロイド溶液においては、超 微粒子を凝集させずに長期にわたって安定に存在させる ととは困難な技術であり、確々工夫がなされるところで あった。

【0004】例えば、安定化剤を用いる例としては、超 微粒子の安定化剤として、ポリビニルアルコールやエチ レングリコールを用い、カドミウム塩や亜鉛塩水溶液と セレン化水素と反応させてセレン化カドミウムあるいは いる(ジャーナル・オブ・ケミカル・フィジックス(Ja urnal of Chemical Physics)第85卷, 2237頁(1986 年))。

【0005】一方、製造する場合の反応溶媒を工夫した 例としては、雹々のアルコールや、N.NLジメチルホルム アミド、アセトニトリルなどの非水溶媒中でのカルコゲ ン化物超微粒子の製造例が知られている。例えば、メタ ノールやプロパノール中での硫化カドミウムや硫化亜鉛 の含成が報告されている(前記 ベリヒテ・ブンゼンゲ ゼルシャフト・フィジカリシェ・ヘミー第88巻,959買, (1984年))。

【0006】との2つの方法を組み合わせた方法、即 ち、反応溶媒として非水溶媒を用い、かつ、安定化剤を 用いる製造方法および組成物を出原人らは先に提案して いる。この長来の中で、半導体超微粒子がポリマー安定 化剤存在の有機溶媒中で製造され、引続き溶媒除去によ って、分散に優れた安定なそれらの征伐粒子/ボリマー 彼合組成物が得られることを開示している。

【0007】半導体超微粒子の製造方法として知られて 20 いる水溶液中や非水溶媒中での製造方法では、例えば、 メタノール中などの極低温では小さな粒子ができること が報告されているが、制御に用いる反応温度幅に対して その効果は大きくなく、実用的に粒径を制御し固定化で きるものではなかった。また、熱アニールなどによって 超微粒子分散状態が変化することが知られていたが、と れを用いて積極的に粒径分布を制御できるとの認識はな かった。その理由としては、同機に反応温度の変化範囲 に対して、粒径変化が小さいためであったものと推測さ れる。

【0008】半導体超像粒子においては、従来の半導体 にはない性質が出現することが期待されている。nmサ イズの半導体関急粒子においては、通常の半導体、すな わち半導体パルク結晶に対して、粒径によって「閉じ込 め」効果が出現するとされている。超像粒子におてる半 等体格品空間の制御によって、大きな光学的な非線形性 や結晶界面反応の特異性が出現することが期待されてい る。したがって、とれらの半導体超微粒子の粒径を削御 するととは光学的に大きな非線形性を得たり、反応性の 例御の面から重要であり、半導体協議粒子の実用上の応 40 用において大きな課題となっていた。

[00009]

【発明が解決しようとする課題】粒経を任意に制御した 安定化された半導体超微粒子の製造手段及びその超微粒 子が分散されたポリマー組成物を得ることを興題とす る。

[0010]

【深脚を解決するための手段】本発明者らは、粒子径を そろえたカルコゲン化物超機粒子およびそれらの超級粒 子/ポリマー組成物を得るべく鋭意研究を行ったとと セレン化亜鉛超激粒子を含成する方法などが報告されて 50 ろ、超微粒子製造における反応温度によって、粒子径分

.. ... , , ... . .. , ,

布が制御可能であることを見いだし、本発明と至った。 【0011】以下、本発明の詳細について説明する。本 発明においては、非水溶媒中で安定化剤存在下、反応提 度を制御しながらカルコゲン化物関徴粒子を製造する。 このカルコゲン化物超段粒子製造のときの反応温度の制 御によって、粒径分布を効率よく側倒することができる ことを特徴とする。

3

[0012] 本発明における超級粒子とは、10から1000 A、好ましくは10から 200Aの平均粒子度径のものであ る。との直径は、一次粒子のそれであっても良いし、ま た一次粒子が凝集して形成する二次粒子の直径であって も織わないが、いずれにしても可視光線に対して透明性 を発現させるには、1000A以上の直径を有する粒子は光 の散乱の上から好ましくない。本発明におけるカルコグ ン化物超像粒子の製造は、金属化合物とカルコゲン化剤 を反応させるととによって行う。

【0013】より詳しくは、金属化合物を含む溶液を、 安定化剤の存在下、必要に応じて機弾しながら、温度を 溶媒の凝固点から溶媒の排点までの任意に設定した温度 に保ち、この溶液中にカルコゲン化剤を添加すると、溶 20 被中に粒径分布の部御された金属カルコゲン化物図像粒 子が生成する。

【0014】本発明における反応温度とは、カルコゲン 化物超微粒子の生成ならびにその成長をおこす溶液温度 をいう。

【0015】本発明における金属化合物としては、亜 鉛、カドミウム、鉛、モリブデン、ビスマス、鋼、水 紙、インジウム、アンチモン、タングステン等のハロゲ ン化物、過塩素酸塩、硝酸塩、有機酸塩、アセチルアセ トナートなどが用いられる。好ましくは、とれらの金属 30 の金属ハロゲン化物、硝酸塩類、通塩素酸塩類、酢酸塩 類が用いられる。とれらは結晶水を含むものであっても かまわない。

【0018】カルコゲン化剤とは、カルコゲン元素を有 し金属化合物と反応する化合物であればよく、好ましく は硫化水素、セレン化水素、テルル化水素などのカルコ ゲン化水素類、硫化ナトリウム、セレン化水素ナトリウ ムなどのカルコゲン化アルキル金属類、硫化ピス(トリ メチルシリル)、セレン化ビス (トリメチルシリル) な 牢の混合物をいう。

【0017】安定化剤としては、アミン化合物やチオー ルやチオフェノール類及びそれらのポリマー類、ポリピ ニルアルコール、ポリエチレングリコールなどのポリア ルコール類など、触極性溶媒の保護コロイドとして作用 するものであればよい。より好ましくは、溶媒除去によ って個級粒子/ポリマー組成物を直接形成できるポリマ -がよく、特に好ましくは、ピロリドン蓝を有するポリ マーが好ましい。

の全て、あるいは一部分にピロリドン基を含む商分子化 合物であって、他の化合物との共配合体でもよい。好ま しくは、ポリピニルピロリドン、Nーピニルピロリドン /スチレン共量合ポリマー、ピニルピロリドン/酢酸ビ ニル共重合ポリマー等の群から選ばれた1つ、或は複数 個のポリマーである。平均分子量は関わないが、溶媒へ の溶解性、取り扱い易さを考えて 500から500000が好ま しい.

【0018】本発明に用いられる反応治媒としては、例 えばピロリドン糞を有するポリマーなどの安定化剤と念 属化合物を所望の成分比で溶解するものであればよい。 このような有機溶媒としては、比較的極性の大きな溶 媒、より具体的にはアセトン、メチルエチルケトンなど のケトン類、アセトニトリル、プロピルニトリルなどの ニトリル類、メタノール、エタノール、プロパノール、 ブチルアルコールなどのアルコール類、シオキサンなど のエーテル類やジメチルホルムアミド、ジメチルスルフ ォキシドなど、或はこれらの混合溶媒、またはこれらを 含有する湿含溶媒であってもよい。

【0020】反応溶液中には、溶媒の除去によって超像 粒子/ボリマー組成物を得るために、他のボリマー成分 をあらかじめמ解させておいてもよい。安定化剤が、ビ ロリドンを有するポリマーなどの高分子であれば、溶膜 除去のみで超微粒子/ポリマー組成物を得るとともでき る。また、じのような方法によって得られた超瞭粒子/ ポリマー組成物の固体状物を、相密性ポリマーと共に有 機溶媒に再溶解させることをもできる。

【0021】ととでいう相溶性ポリマーとは、透明性の ポリマーであると共に使用する有機溶媒に溶解し、か つ、安定化剤を相溶する高分子化合物をいう。好ましい 異体例としては、ポリメチルメタクリレート、ポリカー ボネート、ポリスチレン、ポリエステル、ポリエチレン テレフタレート、ポリ塩化ビニル、ポリエーテルスルホ ン、塩化ビニルと酢酸ビニルの共量合ポリマー、スチレ ンとアクリロニトリルの共産合ポリマーなどが挙げられ

【0022】本発明おいて、観燈した金属カルコゲン化 物超微粒子分散溶液から有機溶媒を滅圧、風粒などによ り除去する場合に、溶液中の粒子径を保持するために どのカルコゲン化シリル化合物、或はこれらの任意の比 40 は、製造温度およびそれ以下の温度のもとで溶媒を除去 する必要がある。製造温度よりも熔媒除去の温度が高い 場合には、溶媒除去の過程で超微粒子の成長がみられ、 特定温度で反応を制御して製造された初期の超像粒子よ りも大きな粒径の超微粒子へ変化する。したがって、一 般的には製造する特定温度よりも低い温度で溶媒を除去 する方法が用いられる。

【0023】しかし、本発明においては、特定温度で制 御して処造した超微粒子の袖液を、意図的に製造傷度よ りも高い温度で処理して、溶液中で製造した阻像粒子の [0018] ピロリドン基を有するポリマーとは、側鎖 50 粒径より大きな任意の大きさの粒子を得るととも出来

(4)

る。また、溶媒除去する温度を製造温度よりも高い温度 でおとなうことによって超敬粒子の成長を行い、任意の 粒径分布の超荷粒子およびその超微粒子/ポリマー組成 物を得ることもできる。

【0024】超微粒子/ポリマー組成物の形態は、通常 の高分子膜について知られているように穏々可能であ り、例えばガラス基板上にキャストするキャスティング 法により容易に数十ヵから数百ヵのフィルムを形成する ことができる。また、スピンコート、ディップコート、 ロールコートなどの薄膜形成方法によって超微粒子分似 10 薄膜を製造することも可能である。

[0025] とのような反応温度によって半導体超微粒 子の粒径制御が可能である理由は、必ずしも全てが明ら かになっているわけではないが、次のように採定してい る。典型的な例として、アセトニトリル落塊中、安定化 剤であるポリビニルビロリドン存在下で硝酸カドミウム と硫化水素を20°Cで反応させたときの反応開始後から40 分後までの2分おきに観察したCdS製造過程を図1に示 す。半導体超像粒子は、粒径が小さいと、その「閉じ込 め」効果により光吸収末端は短波摂にあり、その成長と 20 ともに長波長側に移動してくるととから、製造される粒 径分布を知るととができる。図1 には、 270m付近に吸 収ピークが形成され、この吸収ピークが減少し、 335mm 付近に吸収ビークが出現する過程が頻繁されている。し たがって、粒径の小さなCdS超微粒子ができたのちに、 その粒子が成長していく過程があることがわかる。源度 を制御することによって、おそらく最終的な粒子の成長 **過程が制御されるものと考えれる。** 

【0026】したがって、本発明におけるカルコゲン化 な効果は、非水溶媒と安定化剤をともに用いた超微粒子 製造法において出現してきたものと考えられる。

## [0027]

【実施例】以下、実施例に基づき本発明を説明する。 塞納例1

硝酸カトミウム 4 水和物1.2XLC 'M およびポリピニルビ ロリドン(平均分子量Mw=40000) 8 g/1のアセトニト リル溶液を調製し、これを枝付きの光学測定用石英セル に3mlとりセプタムで蓋をする。この石英セルを通常の 可視-螺外光吸収測定装置の恒温セルホルダー中で、溶 40 存在するときに、反応温度による経験位子の勉強制御効 液温度をそれぞれ、50°C、20°C、0°C、-10°C、-20°C に設定して、光吸収を側定しながら 0.6m1の硫化水素ガ スをセプタムから導入し、硫化カドミウム合成を行っ た。反応開始後、50分後の光吸収スペクトルを図2に示 す。それぞれの反応制度にしたがって、確化カドミウム 超微粒子の電子選移に基づく吸収が異なった液長に出現 するのが見られた。また、との反応溶液をとりだし、設 過型電子顕微鏡鏡察を行ったところ、50°Cでは平均粒子 径80A、20℃では平均粒子径60Aの超微粒子が開棄され

ミウム超微粒子の粒子径が制御されていることがわか

### [0028] 突起例2

突迫例1と間様に、硝酸カドミウム4水和物1.20051M およびポリビニルビロリドン(平均分子量Mw=40000) 8g/1のアセトニトリル溶液を調製し、これを検付きの 光学測定用石英セルに3mlとりセブタムで数をする。と の石英セルを通常の可視一紫外光吸収測定験屋の恒温セ ルホルダー中で、溶液温度を-20°Cに設定して、光吸収 を測定しながら O.GolOの硫化水素ガスをセプタムから導 入し、硫化カドミウム合成を行った。反応開始後、SO分 後の光吸収スペクトルを測定したのち、との溶液温度を 20°Cに昇温し、光吸収スペクトルを測定し、また-20°C に戻したときの吸収スペクトルをそれぞれ、図3に示 す。昇温によって、硫化カドミウム磁微粒子の電子強移 に基づく吸収が長波長へ移助し、硫化カドミウム超微粒 子の粒径が成長しているととがわかる。すなわち、温度 制御によって超微粒子の成長を制御できるととがわか

### 【0029】実施例3

硝酸カドミウム4水和物1.2XLOT'M およびポリビニルビ ロリドン (平均分子量Mw=40000) 8g/1のアセトニト リル裕液を調製し、この溶液5両をセプタムの付いた試 験管中にいれ、恒原権中で、溶液温度をそれぞれ、60 で、40℃、20℃、0℃にする。次に、この容器に酸化水 森ガス1mlをセプタムを通して添加する。10分後、窒然 置換によって強存硫化水素を追い出し、30分室温に放置 した後に、紫外=可視吸収スペクトルを測定したとに ろ、硫化カドミウム超微粒子の電子遷移に華づく吸収が 短線粒子製造上、反応温度による粒子径の側御上の大き 30 それぞれ、 357nm、 345nm、 333nm、 327nmにその吸収 ピークがみられた。とれを図4に示す。また、透過型電 子期微鏡観察により、60℃での製造では平均粒子径80 A、40°Cでの製造では70人の超級粒子が観察された。 [0030]比較例1

> 実施例3の溶液から安定剤であるポリピニルピロリドン を除いた以外は、実施例3と回機に反応をおこなった。 粧果を図5に示す。安定化剤が存在するときの、明かな 硫化カドミウム超像粒子の電子運移に基づく吸収が示す 粒子径の変化は見られなかった。すなわち、安定化剤が 果が大きく出現するととがわかる。

## [0031]比較例2

実施例3の反応熔媒を水に変えたとと以外は、実施例3 と同様に反応操作をおじない、反応温度を50°C、20°C、 5 ℃としたときの結果を図8 に示す。図8 と図4 の比較 から、水を溶媒にした場合には顕著な粒子径制御効果が 英用上得られないことがわかる。

## 【0032】英施例4

突縮例 1 の − 10℃においての反応によって得られた硫化 た。このことから、英用的な反応温度によって強化カド SO カドミウム超微粒子分散溶液を、温度を反応温度の-10 (5)

特簡平5-24826

CK保ちながら、真空デンケーターに入れ、溶液を撹拌 しながら2mmHgの減圧下で溶媒を除去したところ、うす い貸色の国体状物が得られた。との固体の発外・可視吸 収スペクトルは、実施例1のものと一致した。即ち、制 御された超像粒子径のままポリマー組成物を生成してい ることがわかった。

4049495731

### [0033]

【発明の効果】本発明によって、カルコゲン化物超微粒 子及びカルコゲン化物超微粒子/ポリマー組成物の超微 粒子の粒径を実用上制御できる。

### 【図面の個単な説明】

【図1】アセトニトリル中、ポリピロリドン存在下での 硫化カドミウムの生成過程を観察した生成物の光吸収ス ベクトルである。摘軸は観測放長(nm)を、縦軸は吸 光度を表す。各曲線は2分でとの生成物の生成過程を表 し、矢印はその変化の方向を示す。

【図2】実施例1により得られた硫化カドミウム膨微粒 子の光吸収スペクトルである。横翰は観測波長(nm) を、縦軸は吸光度を表す。実線(長波長部)は50°Cでの 反応結果、実線(短波長部)は20℃、点線は0℃、破線 20 は-10°C、一点鎖線は-20°Cでの反応結果を表す。

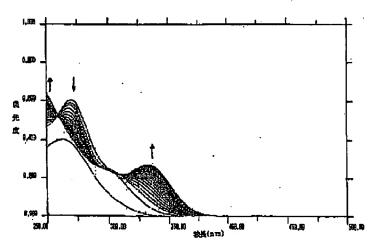
\*【図3】実施例2により得られた硫化カドミウム超微粒 子の光吸収スペクトルである。横軸は観測波長(nm) を、縦軸は吸光度を奏す。実線は-20°Cでの反応結果を 表す。点線はこれを20°Cに昇浪したときの吸収スペクト ルを表し、破線は-20°Cにもどしたときの吸収スペクト ルを表す。

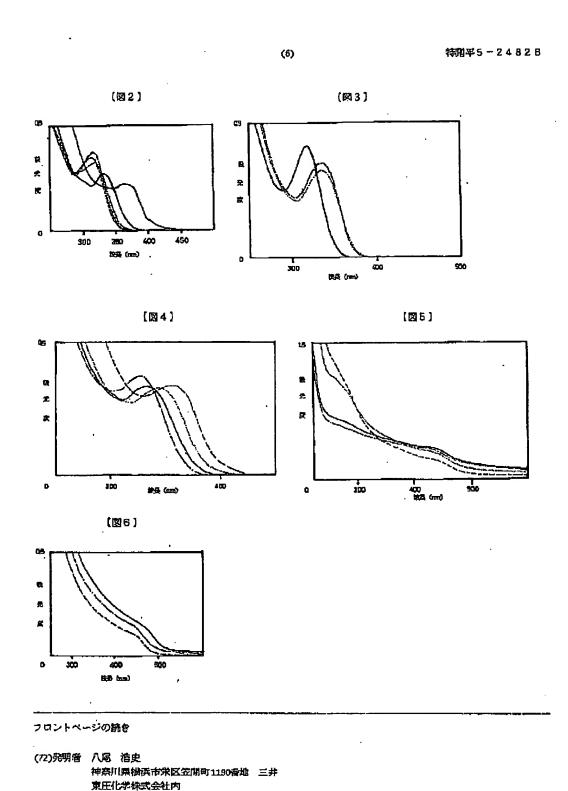
【図4】実施例3により得られた硫化カドミウム超激粒 子の光吸収スペクトルである。横軸は観測波長(nm) を、縦幅は吸光度を表す。破線はGDCでの反応結果、点 10 線は40°C、実線は20°C、一点鎖線は0°Cでの反応結果を 表す.

【図5】比較例1により得られた硫化カドミウム鰹像粒 子の光吸収スペクトルである。複動は観測液長(nm) を、縦軸は吸光度を奏す。破線はのででの反応結果、点 線は40°C、突線は20°C、一点鎖線は0°Cでの反応結果を 表す。

【図6】比較例2により得られた硫化カドミウム超微粒 子の光吸収スペクトルである。樹輔は観測波長(nm) を、柳軸は吸光度を表す。突線は50°Cでの反応結果。 点級級は20°C、破線は5°Cでの反応結果を喪す。







PAGE 17/58 \* RCVD AT 6/10/2008 11:03:14 AM [Eastern Daylight Time] \* SVR:USPTO-EFXRF-5/46 \* DNIS:2738300 \* CSID:4049495731 \* DURATION (mm-ss):24-18